**Симашкевич, Андрей Алексеевич.**

**Контактные явления в тонкопленочных структурах на основе аморфных As2S3 и Sb2S3 : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10. - Кишинев, 1984. - 226 с. : ил.**

**Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Симашкевич, Андрей Алексеевич**

**ВВЕДЕНИЕ**

**Глава I. Контактные явления в структурах на основе халь-когенвдных стеклообразных полупроводников. (Обзор литературных данных).**

**1.1. Электрические свойства сульфида мышьяка и сульфвда сурьмы.**

**1.2. Контактные явления на границе ХСП-металл.**

**1.3. Гетеропереходы и гетероструктуры на основе ЖП.**

**1.3.1 Общие положения.**

**1.3.2 Кристалл аЩ^-ХСП.**

**1.3.3 Кристаллический кремний - ХСП.**

**1.3.4 ЖП-ЖП.**

**1.4. Выводы и постановка задачи.**

**Глава П. Технология получения слоев и гетероструктур на основе ЖП.**

**2.1. Получение слоев и гетероструктур на основе ХСП.**

**2.2. Аппаратура и медики измерений.**

**Глава Ш. Электрические и фотоэлектрические характеристики контакта металл-аморфный полупроводник.**

**3.1. Модель структуры с двойной обедненной областью.**

**3.2. Вольт-амперные характеристики.**

**3.3. Емкостные характеристики.**

**3.3.1 Зависимость емкости структуры от частоты**

**3.3.2 Зависимость емкости структуры от температуры**

**3.3.3 Зависимость емкости от напряжения смещения вольт-фарадные характеристики).**

**3.4. Фото-эдс на контактшх барьерах структур**

**М-ХСД.**

**3.5. Обсуждение результатов. III**

**Выводы по главе**

**Глава JJ, Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур ХСП-ЖП.**

**4.1. Пленочные гетероструктуры в системах записи информации.**

**4.2. Построение энергетической диаграммы гетероструктуры**

**4.3. Экспериментальные результаты и их обсуздение.**

**4.3.1 Фото-эдс**

**4.3.2 Спектры фототока**

**4.3.3 Нестационарный инжекционный ток в гетерострук-турах.**

**4.3.4 Вольт-амперные характеристики**

**4.3.5 Вольт-фарадные характеристики.**